



Masao Horiba Awards 堀場雅夫賞

2026年 対象分野

高効率なエネルギー社会に貢献する先端材料の分析・計測

堀場雅夫賞は「分析・計測」技術を対象として、2003年に設立されました。物質の組成や性質を解明すること、さまざまな現象の意味や影響を把握すること — それはまさに科学の第一歩であり、科学技術や産業発展のための基本的アプローチです。それらのさらなる 探究や革新のため、分析・計測技術は必要不可欠なものです。本賞は、科学技術を支える分析・計測技術の重要性とともに、画期的でユニークな研究をされている研究者・技術者の功績を世に知らしめたいとの創設者 堀場雅夫のおもいを受け継いでいます。本賞の受賞が研究者・技術者の糧となり、今後の研究活動を支える一助になればと願っています。 皆様からのご応募お待ちしております。

堀場雅夫賞アワードディレクター
株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼グループCEO
堀場 厚

●対象分野

パワー半導体および電池材料の研究開発・製造プロセスにおける分析・計測技術を対象とします。

- 1)大電流・高電圧の動作条件下でも高効率な電力制御と電力変換を実現するパワー半導体
- 2)社会生活の様々な環境で基盤技術として活用される二次電池と安全性・信頼性を高めた全固体電池
- 3)エネルギーの多様化を実現する燃料電池や水電解装置および太陽電池

●応募者資格

大学、公的試験機関に所属し、上記分野の研究・開発に従事し、以下のいずれかに該当する、若手研究者・技術者。

- ・上記対象分野において、学術上、技術上の優れた発見、発明を成すことが期待されていること。
- ・上記対象分野において、学術上、技術上の重要な課題の解決が期待されていること。

賞の目的に鑑み、受賞者は応募及び受賞の時点で私企業に所属していないことを前提とします。
なお、年齢条項は設けておりませんが、賞の趣旨に則り、応募者の将来性を重視した審査を行います。

●表彰内容

2026年10月15日(木)に京都大学吉田キャンパスにおいて挙げる授賞式にて、本賞の授与ならびに副賞の贈呈を執り行うとともに、副賞として、200万円を授与します(初年度100万円、次年度100万円)。
次年度分の支給は、受賞後も応募資格条件を満たしていることを要します。
なお、本賞および副賞の受賞は、応募研究を公表できることを条件とします。

●応募要領

本賞ホームページにて公開します。 <https://www.mh-award.org/>



●応募期間・選考方法

2026年3月18日(水)～5月12日(火) ※期日までに書類データ(PDF)を専用フォームよりご提出ください。
審査委員会にて、応募書類を基に、応募者の実績のみならず将来性を重視した審議の上で受賞者を決定します。

●2026堀場雅夫賞 審査委員会(50音順・敬称略)

審査委員長	辰巳砂 昌弘	大阪公立大学 エグゼクティブアドバイザー / 名誉教授
審査委員	松本 広重	九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 副所長 教授
	若宮 淳志	京都大学 化学研究所 教授、京都大学 理事補 / 副プロボスト
	分島 彰男	熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構 教授
海外審査委員	Eric A. Starch	Robert D. Bent Professor of Engineering, Department of Materials Science and Engineering, University of Pennsylvania
	Jon-In Shim	Professor Emeritus, Hanyang University
社内審査委員	井上 正規	株式会社堀場エステック 開発本部 副本部長
	樋口 誠司	株式会社堀場製作所 先端材料・半導体技術本部 先端材料ソリューション部 部長
実行委員長	足立 正之	株式会社堀場製作所 代表取締役社長
副実行委員長	中村 博司	株式会社堀場製作所 常務執行役員 CTO

世界がカーボンニュートラルという大きな社会目標に向かうなか、再生可能エネルギーの導入拡大や電動化の進展に伴い、社会全体の電力システムを支える技術基盤の重要性が一層高まっています。近年は、AIの社会実装の加速やデータセンターの増設、通信インフラの高度化などを背景に、電力需要が急速に増加する可能性も指摘されており、安定供給の確保と環境負荷低減を両立する技術革新が急務です。なかでも、エネルギー変換・貯蔵デバイスの高効率化と高信頼化は、省エネルギー化とCO₂排出削減を同時に実現するための重要な鍵であり、材料開発と製造プロセスの高度化が強く求められています。とりわけ、パワー半導体、二次電池、燃料電池・水電解、太陽電池などのエネルギーデバイスは、次世代の社会基盤技術として期待が高まっています。

パワー半導体分野では、電力インフラ、産業機器、電気自動車など幅広い分野での応用が期待されるなか、高電圧・高周波動作下で高効率な電力制御および変換を実現する材料や半導体プロセス技術が求められています。そのため、SiC(炭化ケイ素)、GaN(窒化ガリウム)、Ga₂O₃(酸化ガリウム)、ダイヤモンドなどのワイドバンドギャップ半導体材料に加え、それらの結晶成長やデバイスプロセス技術を支える分析・計測技術の開発が不可欠となっています。

蓄電の分野では、リチウムイオン電池を中心とする二次電池が、身の回りのあらゆる機器に広く浸透しています。近年では、エネルギー密度、安全性、耐久性の向上を目的に、全固体電池の実用化を目指し、固体電解質や正極・負極材料に関する研究開発が活発化しています。また発電の分野では、エネルギー源の多様化に向けて、燃料電池・水電解装置に用いる触媒・電解質膜や、ペロブスカイト型太陽電池の膜材など、発電性能や耐久性向上を目指した材料研究も進んでいます。これら電極、膜材などの材料開発においても、分析・計測技術の発展が欠かせません。

以上を踏まえ、本賞ではエネルギー関連デバイスの高性能化および信頼性向上に貢献する材料開発、ならびに製造プロセスの実現と高度化を支える分析・計測技術に関する研究に焦点を当て、2026堀場雅夫賞のテーマを「高効率なエネルギー社会に貢献する先端材料の分析・計測技術」に設定しました。これらの研究に日々意欲的に取り組まれる若手研究者・技術者の皆様からのご応募をお待ちしております。

2026堀場雅夫賞実行委員長
株式会社堀場製作所 代表取締役社長
足立 正之



2025堀場雅夫賞 授賞式

堀場雅夫賞についてのお問い合わせ先

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 株式会社堀場製作所内 堀場雅夫賞事務局

TEL: 075-325-5110 E-mail: info@mh-award.org URL <https://www.mh-award.org/>